

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2023年5月4日(04.05.2023)



(10) 国際公開番号

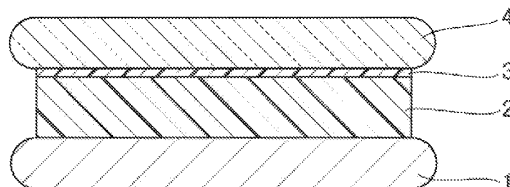
WO 2023/074324 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 21/02 (2006.01) *B32B 27/00* (2006.01)
B32B 7/023 (2019.01) *H01L 21/304* (2006.01)
B32B 7/025 (2019.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2022/037649
- (22) 国際出願日: 2022年10月7日(07.10.2022)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2021-177168 2021年10月29日(29.10.2021) JP
- (71) 出願人: 日産化学株式会社(NISSAN CHEMICAL CORPORATION) [JP/JP]; 〒1036119 東京都中央区日本橋二丁目5番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 奥野 貴久 (OKUNO Takahisa); 〒9392792 富山県富山市婦中町笹倉635 日産化学株式会社材料科学研究所内 Toyama (JP). 岸岡 高広(KISHIOKA Takahiro); 〒9392792 富山県富山市婦中町笹倉635 日産化学株式会社材料科学研究所内 Toyama (JP). 新城 徹也(SHINJO Tetsuya); 〒9392792 富山県富山市婦中町笹倉635 日産化学株式会社材料科学研究所内 Toyama (JP).
- (74) 代理人: 高岡 亮一, 外 (TAKAOKA Ryoichi et al.); 〒1710021 東京都豊島区西池袋5-4-7 池袋トーセイビル5階 高岡 I P 特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,

(54) Title: LAMINATE, RELEASE AGENT COMPOSITION, AND METHOD FOR MANUFACTURING PROCESSED SEMICONDUCTOR SUBSTRATE

(54) 発明の名称: 積層体、剥離剤組成物及び加工された半導体基板の製造方法

【図1】



(57) Abstract: The present invention provides a laminate that has: a semiconductor substrate; a light-transmissive support substrate; and, an adhesive layer and a release layer that are provided between the semiconductor substrate and the support substrate, the laminate being used for separating the semiconductor substrate and the support substrate after the release layer absorbs light irradiated from the support substrate side. The release layer is formed from a release agent composition. The release agent composition contains a light-absorbing compound having a molecular weight of 2,000 or less. When the absorption spectrum of the light-absorbing compound in the range of 250-800 nm is measured, the absorption spectrum has a maximum value, at which absorbance is highest within the range of 250-800 nm, between 250 nm and 350 nm.

(57) 要約: 半導体基板と、光透過性の支持基板と、前記半導体基板と前記支持基板との間に設けられた、接着層と剥離層とを有し、前記支持基板側から照射された光を前記剥離層が吸収した後に前記半導体基板と前記支持基板とが分離されることに用いられる積層体であって、前記剥離層が、剥離剤組成物から形成される層であり、前記剥離剤組成物が、分子量が2,000以下の光吸収性化合物を含有し、前記光吸収性化合物について250nm~800nmの範囲の吸収スペクトルを測定した際に、前記吸収スペクトルが、250nm~800nmの範囲内で吸光度が最も大きい極大値を250nm~350nmの間に有する、積層体。

〔続葉有〕

WO 2023/074324 A1

CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,
HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP,
KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK,
LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX,
MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH,
PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG,
SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ,
UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告 (条約第21条(3))